

18 Mbit (512 K × 36/1 M × 18) 流水线 SRAM

特性

- 支持总线的运行速度高达 250 MHz
- 可用的速度范围为 250、200 和 167 MHz
- 流水线操作的输入和输出寄存器
- 3.3 V 内核电源
- 2.5 V 或 3.3 V I/O 电源
- 快速的时钟至输出的时间
 - 2.5 ns (对于 250 MHz 器件)
- 提供了高性能的 3-1-1-1 访问速率
- 独立的处理器和控制器地址探针
- 同步自定时写操作
- 异步输出使能
- 单周期芯片取消选择
- CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 适用于 JEDEC 标准无铅 100-TQFP 封装和含铅 165-FBGA 封装。
- 与 IEEE 1149.1 JTAG 相兼容的边界扫描
- 提供 ZZ 睡眠模式选项

产品选择指南

说明		250 MHz	200 MHz	167 MHz	单位
最大访问时间		2.5	3.2	3.4	ns
最大工作电流	× 18	180	158	143	mA
	× 36	200	178	163	

功能描述

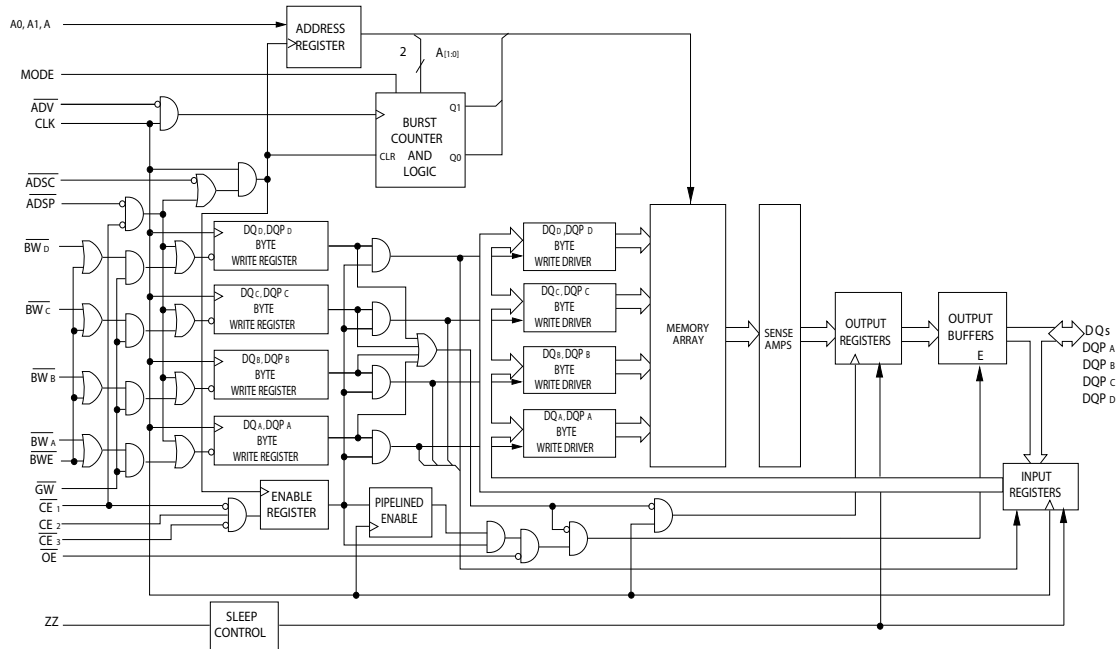
CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 SRAM 集成了 524,288 × 36 和 1,048,576 × 18 SRAM 单元、先进的同步外围电路和用于内部突发操作的 2 位计数器。所有同步输入均通过上升沿触发的时钟输入 (CLK) 控制的寄存器进行门控。同步输入包括所有地址、数据输入、地址流水线芯片使能 (\overline{CE}_1)、深度扩展芯片使能 (CE_2 和 \overline{CE}_3)、突发控制输入 (\overline{ADSC} 、 \overline{ADSP} 以及 \overline{ADV})、写使能 (\overline{BW}_x 和 \overline{BWE}) 以及全局写入 (\overline{GW})。异步输入包括输出使能 (\overline{OE}) 和 ZZ 引脚。

当地址探针处理器 (\overline{ADSP}) 或地址探针控制器 (\overline{ADSC}) 处于活动状态时，地址和芯片使能信号都在时钟的上升沿上被寄存。当 Advance 引脚 (\overline{ADV}) 控制后续突发地址时，会内部生成它们。

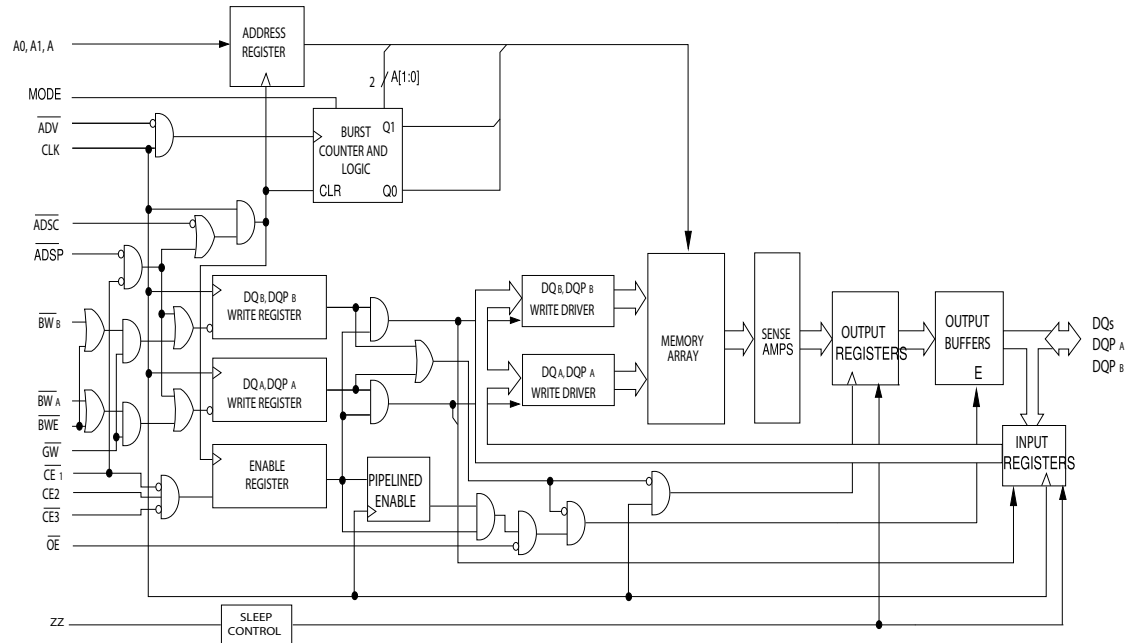
地址、数据输入和写控制被寄存在芯片上，以便初始自定时写周期。该器件支持字节写操作 (欲了解更详细的信息，请参考第 6 页上的引脚定义和第 10 页上的真值表)。当字节写控制输入控制写周期时，该周期会具有一个、两个或四个字节宽。当 \overline{GW} 为低电平有效时，将会对所有字节进行写操作。

CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 运行时的内核供电电压等于或高于 +3.3 V，而所有输出运行时的供电电压为 +2.5 或 +3.3 V。所有输入和输出都与 JEDEC 标准和 JESD8-5 相兼容。

逻辑框图 — CY7C1380KV33



逻辑框图 — CY7C1382KV33

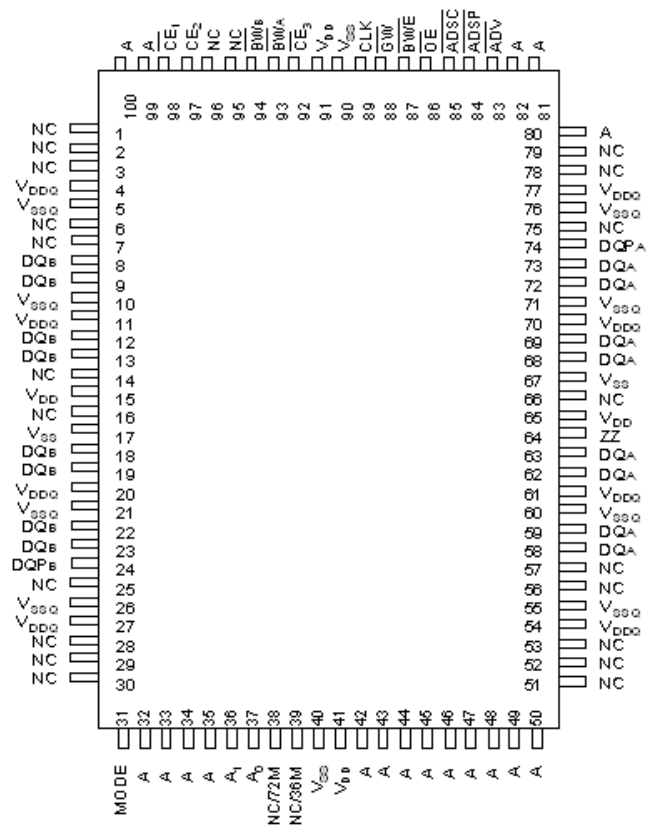


目录

引脚配置	4	TAP 直流电气特性与工作条件	17
引脚定义	6	标识寄存器定义	18
功能概述	8	扫描寄存器大小	18
单一读访问	8	标识代码	18
ADSP 启动的单一写入访问	8	边界扫描顺序	19
ADSC 启动的单一写入访问	8	最大额定值	20
突发序列	8	工作范围	20
睡眠模式	9	抗中子软失效	20
交错突发地址表	9	电气特性	20
线性突发地址表	9	电容	22
ZZ 模式的电气特性	9	热阻	22
真值表	10	交流测试负载和波形	22
读 / 写操作的真值表	11	切换特性	23
读 / 写操作的真值表	11	切换波形	24
IEEE 1149.1 串行边界扫描 (JTAG)	12	订购信息	28
禁用 JTAG 特性	12	订购代码定义	28
测试端口 (TAP)	12	封装图	29
执行 TAP 复位	12	缩略语	31
TAP 寄存器	12	文档规范	31
TAP 指令集	13	测量单位	31
TAP 控制器状态图	14	文档修订记录	32
TAP 控制器框图	15	销售、解决方案和法律信息	33
TAP 时序	16	全球销售和 design 支持	33
TAP 交流开关特性	16	产品	33
3.3 V TAP 交流测试条件	17	PSoC® 解决方案	33
3.3 V TAP 交流输出负载等效	17	赛普拉斯开发者社区	33
2.5 V TAP 交流测试条件	17	技术支持	33
2.5 V TAP 交流输出负载等效	17		

图 1. 100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) 引脚分布 (3 芯片使能)

CY7C1382KV33 (1 M x 18)



引脚配置 (续)

图 2. 165-FBGA (13 x 15 x 1.4 mm) 引脚分布 (3 芯片使能)

CY7C1380KV33 (512 K x 36)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	NC/288M	A	\overline{CE}_1	\overline{BW}_C	\overline{BW}_b	\overline{CE}_3	\overline{BWE}	\overline{ADSC}	\overline{ADV}	A	NC
B	NC/144M	A	CE2	\overline{BW}_D	\overline{BW}_A	CLK	\overline{GW}	\overline{OE}	\overline{ADSP}	A	NC/576M
C	DQP _C	NC	V _{DDQ}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DDQ}	NC/1G	DQP _B
D	DQ _C	DQ _C	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _b	DQ _b
E	DQ _C	DQ _C	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _b	DQ _b
F	DQ _C	DQ _C	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _b	DQ _b
G	DQ _C	DQ _C	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _b	DQ _b
H	NC	NC	NC	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	NC	NC	ZZ
J	DQ _D	DQ _d	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _a	DQ _a
K	DQ _D	DQ _d	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _A	DQ _A
L	DQ _D	DQ _d	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _a	DQ _a
M	DQ _D	DQ _d	V _{DDQ}	V _{DD}	V _{SS}	V _{SS}	V _{SS}	V _{DD}	V _{DDQ}	DQ _a	DQ _a
N	DQP _D	NC	V _{DDQ}	V _{SS}	NC	A	NC	V _{SS}	V _{DDQ}	NC	DQP _A
P	NC	NC/72M	A	A	TDI	A1	TDO	A	A	A	A
R	MODE	NC/36M	A	A	TMS	A0	TCK	A	A	A	A

引脚定义

名称	I/O	说明
A ₀ 、A ₁ 、A	输入 同步	用于选择地址的地址输入。如果 ADSP 或 ADSC 为低电平有效，这些输入将采样在 CLK 的上升沿上，并 CE ₁ 、CE ₂ 和 CE ₃ 被有效采样。A1:A0 将输入到 2 位计数器。
BW _A 、BW _B 、 BW _C 、BW _D	输入 同步	低电平有效的字节写选择输入。同 BWE 结合使用，以可以将字节写入到 SRAM 内。在 CLK 时钟的上升沿上被采样。
GW	输入 同步	低电平有效的全局写使能输入。当在 CLK 上升沿上将该输入置为低电平时，将会执行全局写入（可以写入所有字节，无论 BW _x 和 BWE 上的值如何）。
BWE	输入 同步	低电平有效的字节写入使能输入。在 CLK 时钟的上升沿上被采样。必须将该信号置为低电平，以执行字节写入。
时钟	时钟输入	时钟输入。用于将所有同步输入捕获到器件内。另外，在进行突发操作期间，当 ADV 被置为低电平时，可以使用该输入来递增突发计数器。
CE ₁	输入 同步	低电平有效的芯片使能 1 输入。在 CLK 时钟的上升沿上被采样。同 CE ₂ 和 CE ₃ 一起使用时，可以选择或取消选择器件。如果 CE ₁ 为高电平，ADSP 将被忽略。只有加载了新的外部地址时，CE ₁ 才被采样。
CE ₂	输入 同步	高电平有效的芯片使能 2 输入。在 CLK 时钟的上升沿上被采样。同 CE ₁ 和 CE ₃ 一起使用时，可以选择或取消选择器件。只有加载了新的外部地址时，CE ₂ 才被采样。
CE ₃	输入 同步	低电平有效的芯片使能 3 输入。在 CLK 时钟的上升沿上被采样。同 CE ₁ 和 CE ₂ 一起使用时，可以选择或取消选择器件。只有加载了新的外部地址时，CE ₃ 才被采样。
OE	异步输入	输出使能，异步输入，低电平有效。控制 I/O 引脚的方向。置为低电平时，I/O 引脚作为输出使用。取消置位为高电平时，I/O 引脚处于三态的，并作为输入数据引脚使用。OE 退出取消选择状态后，在读周期的第一个时钟周期，该信号被屏蔽。
ADV	输入 同步	高级输入信号在 CLK 时钟的上升沿上被采样，低电平有效。被激活时，它将自动递增突发周期中的地址。
ADSP	输入 同步	处理器中的地址探针，在 CLK 时钟的上升沿上被采样，低电平有效。置为低电平时，发送到器件的地址将在地址寄存器中捕获。另外，也将 A1:A0 加载到突发计数器中。ADSP 和 ADSC 均被激活时，只有 ADSP 被检测。CE ₁ 被取消置位为高电平时，ADSP 被忽略。
ADSC	输入 同步	控制器中的地址探针，在 CLK 时钟的上升沿上被采样，低电平有效。置为低电平时，发送到器件的地址将在地址寄存器中捕获。另外，也将 A1:A0 加载到突发计数器中。ADSP 和 ADSC 均被激活时，只有 ADSP 被检测。
ZZ	异步输入	ZZ “睡眠” 输入。这个有效的高电平输入可使器件处于时间不重要的“睡眠”状态，并保存数据的完整性。正常工作时，必须将该引脚设为低电平或处于悬空状态。ZZ 引脚带有一个内部下拉电阻。
DQs, DQP _x	同步 I/O	双向数据 I/O 线。作为输入，这些线将数据发送到片上数据寄存器内，该操作在 CLK 的上升沿上触发。作为输出，在前半个时钟读周期的上升沿内，它们将发送存储器内指定位置地址中的数据。这些引脚的方向由 OE 控制。将 OE 置为低电平时，这些引脚作为输出使用。将该信号置为高电平时，DQs 和 DQP _x 都处于三态。
V _{DD}	电源	器件内核的电源输入。
V _{SS}	接地	器件内核的接地引脚。
V _{SSQ}	I/O 接地	I/O 电路的接地引脚。
V _{DDQ}	I/O 供电电源	I/O 电路的电源电压。
MODE	静态输入	选择突发顺序。连接到 GND 时，选择线性突发序列。连接到 V _{DD} 或处于悬空时，选择交错突发序列。这是一个短接（strap）引脚，并在器件运行时应保持该引脚的静态状态。Mode 引脚具有一个内部上拉电阻。

引脚定义 (续)

名称	I/O	说明
TDO	同步的 JTAG 串行输出	JTAG 电路的串行数据输出。 在 TCK 的下降沿上发送数据。如果没有使用 JTAG 特性，请断开同该引脚的连接。该引脚在 TQFP 封装上不可用。
TDI	同步的 JTAG 串行输入	JTAG 电路的串行数据输入。 在 TCK 时钟的上升沿上被采样。如果未使用 JTAG 功能，该引脚可以被断接或连接到 V_{DD} 。该引脚在 TQFP 封装上不可用。
TMS	同步的 JTAG 串行输入	JTAG 电路的串行数据输入。 在 TCK 时钟的上升沿上被采样。如果未使用 JTAG 功能，该引脚可以被断接或连接到 V_{DD} 。该引脚在 TQFP 封装上不可用。
TCK	JTAG 时钟	JTAG 电路的时钟输入。 如果未使用 JTAG 功能，请将该引脚连接至 V_{SS} 。该引脚在 TQFP 封装上不可用。
NC	—	无连接。 36 M、72 M、144 M、288 M、576 M 和 1 G 是地址扩展引脚，并未内部连接至芯片。

功能概述

所有同步输入均通过由时钟的上升沿控制的输入寄存器。所有数据输出均通过时钟的上升沿控制的输出寄存器。从时钟上升沿的最长访问延迟 (t_{CO}) 为 2.5 ns (250 MHz 器件)。

CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 支持各个采用了线性或交错突发序列的系统中的辅助缓存。线性突发序列适用于使用了一个线性突发序列的处理器。用户可以选择突发顺序, 并通过采样 **MODE** 输入可以确定该顺序。通过处理器地址探针 (**ADSP**) 或控制器地址探针 (**ADSC**), 可以开始访问。**ADV** 输入控制突发序列的地址增加。2 位的片上环绕式突发计数器捕获突发序列中的第一个地址, 并自动递增其余突发访问的地址。

字节写操作取决于字节写使能 (**BWE**) 和字节写选择 (**BW_X**) 输入。全局写使能 (**GW**) 覆盖了所有字节写输入, 并将数据写入到所有四个字节内。所有写操作都通过片上同步自定时写电路得到简化。

这些器件提供了三个同步芯片选择 (**CE₁**、**CE₂**、**CE₃**) 和一个异步输出使能 (**OE**), 从而可以轻松地进行组选择和输出三态控制。如果 **CE₁** 为高电平, **ADSP** 将被忽略。

单一读访问

如果在时钟上升沿过程中满足以下条件, 将启动该访问:

(1) **ADSP** 或 **ADSC** 被置为低电平; (2) **CE₁**、**CE₂**、**CE₃** 均有效; (3) 写信号 (**GW**、**BWE**) 都被取消置位为高电平。如果 **CE₁** 为高电平, **ADSP** 将被忽略。发送到地址输入 (**A**) 的地址被存储在地址增加逻辑和地址寄存器中, 同时被发送到寄存器阵列。相应的数据传输到输出寄存器的输入。在下一个时钟的上升沿上, 如果 **OE** 为低电平有效, 则数据将在 2.5 ns (250 MHz 器件) 时间内通过输出寄存器发送到数据总线。只能发生一个例外的是, 当 **SRAM** 从取消选择状态转到选择状态时, 其输出在第一次访问周期内一直处于三态。第一次访问周期后, **OE** 信号会控制该输出。连续的单一读取周期得到支持。一旦 **SRAM** 在时钟上升沿上由芯片选择和 **ADSP** 或 **ADSC** 信号取消选择, 其输出将立即为三态。

ADSP 启动的单一写入访问

如果在时钟上升沿上满足以下条件, 将启动写访问: (1) **ADSP** 为低电平; (2) **CE₁**、**CE₂** 和 **CE₃** 都有效。将发送到 **A** 的地址加载到地址寄存器和地址增加逻辑中, 同时将其发送到存储器阵列。

在第一个周期内, 写输入信号 (**GW**、**BWE** 及 **BW_X**) 和 **ADV** 输入都被忽略。

ADSP 触发的写访问需要占用两个时钟周期来完成。如果 **GW** 在第二个时钟上升沿上被置为低电平, 将发送到 **DQs** 输入的数据写入到存储器阵列中的相应地址。如果 **GW** 为高电平, 那么写操作会由 **BWE** 和 **BW_X** 信号控制。

CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 提供了字节写入功能, 如写周期说明表中的内容所述。如果置位字节写入使能输入 (**BWE**) 和所选的字节写入 (**BW_X**) 输入, 将会对所需的字节进行写操作。字节写入操作中未选中的字节将保持不变。通过所提供的同步自定时写入机制, 可以轻松进行写操作。

由于 CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 是通用 I/O 器件, 所以将数据发送到 **DQs** 输入前, 必须将输出使能 (**OE**) 取消置为高电平。这样可使输出驱动器处于三态。为安全起见, 无论 **OE** 的状态如何, 每当检测到写周期时, **DQs** 将自动进入三态。

ADSC 启动的单一写入访问

如果满足以下条件, 将启动 **ADSC** 写访问: (1) **ADSC** 为低电平 (2) **ADSP** 被取消置位为高电平; (3) **CE₁**、**CE₂**、**CE₃** 都有效 (4) 写输入的合适组合 (**GW**、**BWE** 及 **BW_X**) 都有效, 以便写入所需字节。**ADSC** 触发的写访问仅需要一个时钟周期来完成。将发送到 **A** 的地址加载到地址寄存器和地址增加逻辑中, 同时将其发送到存储器阵列。**ADV** 输入在该周期内被忽略。如果执行全局写入, 那么将发送到 **DQs** 的数据写入到存储器阵列中的相应地址。如果执行了字节写入, 那么只有被选中的字节才被写入。字节写入操作中未选中的字节将保持不变。通过所提供的同步自定时写入机制, 可以轻松进行写操作。

由于 CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 是通用 I/O 器件, 所以将数据发送到 **DQs** 输入前, 必须将输出使能 (**OE**) 取消置为高电平。这样可使输出驱动器处于三态。为安全起见, 无论 **OE** 的状态如何, 每当检测到写周期时, **DQs** 将自动进入三态。

突发序列

CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 提供了 2 位包裹计数器; **A1:A0** 将输入到该计数器中, 它会实现交错或线性突发序列。用户可以通过 **MODE** 输入选择突发序列。

如果在时钟上升沿上置位 **ADV** 为低电平, 突发计数器会自动增加到突发序列中的下一个地址。读取和写入突发操作均受支持。

睡眠模式

ZZ 输入引脚是一个异步输入。置位 ZZ 后，SRAM 将进入节能的睡眠模式。进入和退出睡眠模式时，需要占用两个时钟周期。在该模式中，数据完整性得到保证。不将进入睡眠模式时被挂起的访问视为有效访问，同时不能确保完成该操作。进入睡眠模式之前，必须取消选择该器件。 \overline{CE}_1 、 \overline{CE}_2 、 \overline{CE}_3 、 \overline{ADSP} 以及 \overline{ADSC} 在 ZZ 输入为低电平后的 t_{ZZREC} 时间内必须保持无效状态。

交错突发地址表

(MODE = 悬空或 V_{DD})

第一个地址 A1:A0	第二个地址 A1:A0	第三个地址 A1:A0	第四个地址 A1:A0
00	01	10	11
01	00	11	10
10	11	00	01
11	10	01	00

线性突发地址表

(MODE = GND)

第一个地址 A1:A0	第二个地址 A1:A0	第三个地址 A1:A0	第四个地址 A1:A0
00	01	10	11
01	10	11	00
10	11	00	01
11	00	01	10

ZZ 模式的电气特性

参数	说明	测试条件	最小值	最大值	单位
I_{DDZZ}	睡眠模式下的待机电流	$ZZ \geq V_{DD} - 0.2 V$	—	65	mA
t_{ZZS}	器件从运行状态到进入 ZZ 模式	$ZZ \geq V_{DD} - 0.2 V$	—	$2t_{CYC}$	ns
t_{ZZREC}	ZZ 恢复时间	$ZZ \leq 0.2 V$	$2t_{CYC}$	—	ns
t_{ZZI}	ZZ 从活动状态到进入睡眠电流的	该参数被采样	—	$2t_{CYC}$	ns
t_{RZZI}	ZZ 从非活动状态到退出睡眠电流	该参数被采样	0	—	ns

真值表

CY7C1380KV33/CY7C1382KV33 的真值表如下所示。[1、2、3、4、5]

操作	所使用的地址	\overline{CE}_1	CE_2	\overline{CE}_3	ZZ	\overline{ADSP}	\overline{ADSC}	\overline{ADV}	\overline{WRITE}	\overline{OE}	CLK	DQ
取消选择周期、断电	无	H	X	X	L	X	L	X	X	X	L-H	三态
取消选择周期、断电	无	L	L	X	L	L	X	X	X	X	L-H	三态
取消选择周期、断电	无	L	X	H	L	L	X	X	X	X	L-H	三态
取消选择周期、断电	无	L	L	X	L	H	L	X	X	X	L-H	三态
取消选择周期、断电	无	L	X	H	L	H	L	X	X	X	L-H	三态
睡眠模式、断电	无	X	X	X	H	X	X	X	X	X	X	三态
读周期、开始传输	外部地址	L	H	L	L	L	X	X	X	L	L-H	Q
读周期、开始传输	外部地址	L	H	L	L	L	X	X	X	H	L-H	三态
写周期、开始传输	外部地址	L	H	L	L	H	L	X	L	X	L-H	D
读周期、开始传输	外部地址	L	H	L	L	H	L	X	H	L	L-H	Q
读周期、开始传输	外部地址	L	H	L	L	H	L	X	H	H	L-H	三态
读周期、继续传输	下一个地址	X	X	X	L	H	H	L	H	L	L-H	Q
读周期、继续传输	下一个地址	X	X	X	L	H	H	L	H	H	L-H	三态
读周期、继续传输	下一个地址	H	X	X	L	X	H	L	H	L	L-H	Q
读周期、继续传输	下一个地址	H	X	X	L	X	H	L	H	H	L-H	三态
写周期、继续传输	下一个地址	X	X	X	L	H	H	L	L	X	L-H	D
写周期、继续传输	下一个地址	H	X	X	L	X	H	L	L	X	L-H	D
读周期、停止传输	当前地址	X	X	X	L	H	H	H	H	L	L-H	Q
读周期、停止传输	当前地址	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L-H	三态
读周期、停止传输	当前地址	H	X	X	L	X	H	H	H	L	L-H	Q
读周期、停止传输	当前地址	H	X	X	L	X	H	H	H	H	L-H	三态
写周期、停止传输	当前地址	X	X	X	L	H	H	H	L	X	L-H	D
写周期、停止传输	当前地址	H	X	X	L	X	H	H	L	X	L-H	D

注释:

1. X = 无需关注, H = 逻辑高电平, L = 逻辑低电平。
2. 任意一个或多个字节写入使能信号和 $\overline{BWE} = L$ 或 $\overline{GW} = L$ 时, $\overline{WRITE} = L$ 。所有字节写入使能信号、 \overline{BWE} 、 $\overline{GW} = H$ 时, $\overline{WRITE} = H$ 。
3. DQ 引脚由当前周期和 \overline{OE} 信号控制。 \overline{OE} 是异步信号,并不在时钟边沿上被采样。
4. 无论 \overline{GW} 、 \overline{BWE} 或 \overline{BW}_x 的状态如何,激活 \overline{ADSP} 时, SRAM 始终会启动读周期。 \overline{ADSP} 或 \overline{ADSC} 被置为高电平后,在后续时钟周期中才能发生写操作。因此,启动写周期前,必须将 \overline{OE} 驱动为高电平,这样才能使输出处于三态。启动写周期后, \overline{OE} 的状态为“无需关注”。
5. \overline{OE} 是异步信号,并且不能在时钟上升沿上进行采样。该信号在写周期中被内部屏蔽。在读周期中, \overline{OE} 为无效或取消选择器件时,所有数据位均是三态的,并且 \overline{OE} 低电平有效时,所有数据位都作为输出使用。

读 / 写操作的真值表

CY7C1380KV33 读 / 写操作的真值表如下所示。[6、7]

函数 (CY7C1380KV33)	\overline{GW}	\overline{BWE}	$\overline{BW_d}$	$\overline{BW_C}$	$\overline{BW_B}$	$\overline{BW_a}$
读取	H	H	X	X	X	X
读取	H	L	H	H	H	H
写入字节 A — (DQ _A 和 DQP _A)	H	L	H	H	H	L
写入字节 B — (DQ _B 和 DQP _B)	H	L	H	H	L	H
写入字节 B 和 A	H	L	H	H	L	L
写入字节 C — (DQ _C 和 DQP _C)	H	L	H	L	H	H
写入字节 C 和 A	H	L	H	L	H	L
写入字节 C 和 B	H	L	H	L	L	H
写入字节 C、B 和 A	H	L	H	L	L	L
写入字节 D — (DQ _D 和 DQP _D)	H	L	L	H	H	H
写入字节 D 和 A	H	L	L	H	H	L
写入字节 D 和 B	H	L	L	H	L	H
写入字节 D、B 和 A	H	L	L	H	L	L
写入字节 D 和 C	H	L	L	L	H	H
写入字节 D、C 和 A	H	L	L	L	H	L
写入字节 D、C 和 B	H	L	L	L	L	H
写入所有字节	H	L	L	L	L	L
写入所有字节	L	X	X	X	X	X

读 / 写操作的真值表

CY7C1382KV33 读 / 写操作的真值表如下所示。[6、7]

函数 (CY7C1382KV33)	\overline{GW}	\overline{BWE}	$\overline{BW_B}$	$\overline{BW_a}$
读取	H	H	X	X
读取	H	L	H	H
写入字节 A — (DQ _A 和 DQP _A)	H	L	H	L
写入字节 B — (DQ _B 和 DQP _B)	H	L	L	H
写入字节 B 和 A	H	L	L	L
写入所有字节	H	L	L	L
写入所有字节	L	X	X	X

注释:

6. X = 无需关注, H = 逻辑高电平, L = 逻辑低电平。

7. 该表仅列出了字节写入组合的一部分。 $\overline{BW_x}$ 的所有组合均有效。根据有效的字节写入, 将执行相应的写操作。

IEEE 1149.1 串行边界扫描 (JTAG)

CY7C1380KV33 集成了一个串行边界扫描测试端口 (TAP)。该器件完全符合 1149.1 标准。TAP 在工作时采用了 JEDEC 标准的 3.3 V 或 2.5 V IO 逻辑电平。

CY7C1380KV33 包含 TAP 控制器、指令寄存器、边界扫描寄存器、旁路寄存器和 ID 寄存器。

禁用 JTAG 特性

无需使用 JTAG 特性也可以运行 SRAM。要禁用 TAP 控制器，要将 TCK 置为低电平 (V_{SS})，以防止有额外的时钟输入到器件内。TDI 和 TMS 是内部上拉，并可处于未连接状态。它们也可以通过上拉电阻连接到 V_{DD} 。TDO 必须保持未连接状态。上电时，器件会被复位，这样不会干扰器件的工作。

测试端口 (TAP)

测试时钟 (TCK)

测试时钟仅能与 TAP 控制器配合使用。所有输入都在 TCK 的上升沿上进行捕获。所有输出都从 TCK 的下降沿上被输出。

测试模式选择 (TMS)

TMS 输入用于向 TAP 控制器提供指令，并在 TCK 的上升沿上被采样。如果未使用 TAP，此引脚可以保持未连接状态。由于该球形焊盘是内部上拉的，因此可产生逻辑高电平。

测试数据输入 (TDI)

TDI 接口用于以串行方式将信息输入到寄存器中，并且可以连接到任何寄存器的输入。TDI 和 TDO 之间的寄存器由加载到 TAP 指令寄存器中的指令选择。有关加载指令寄存器的信息，请参见第 14 页上的 [TAP 控制器状态图](#)。TDI 是内部上拉。如果在应用中未使用 TAP，TDI 可以保持未连接状态。TDI 连接到任何寄存器中的最高有效位 (MSB)。

测试数据输出 (TDO)

TDO 输出球形焊盘用于以串行方式发送寄存器的时钟数据。输出有效，这取决于 TAP 状态机的当前状态（请参见第 18 页上的 [标识代码](#)）。输出会在 TCK 的下降沿上发生变化。TDO 连接到任何寄存器的最低有效位 (LSB)。

执行 TAP 复位

通过强制使 TMS 高电平 (V_{DD}) 保持五个 TCK 上升沿，即可进行复位。该复位不会影响 SRAM 的工作，并可在 SRAM 工作期间执行。

在上电时，TAP 会在内部复位，以确保 TDO 处于高阻态。

TAP 寄存器

此类寄存器位于 TDI 和 TDO 接口之间，用于扫描 SRAM 测试电路的数据输入和输出。通过指令寄存器每次只能选择一个寄存器。在 TCK 的上升沿上，数据会以串行方式加载到 TDI 接口。在 TCK 的下降沿上，数据会从 TDO 接口输出。

指令寄存器

三位指令会以串行方式加载到指令寄存器中。该寄存器在置于 TDI 和 TDO 接口之间时被加载，如第 15 页上的 [TAP 控制器框图](#) 所示。在上电时，指令寄存器会加载 IDCODE 指令。即使控制器处于复位状态，也会加载 IDCODE 指令，如上一节所述。

当 TAP 控制器处于 Capture-IR 状态时，两个最低有效位会被加载为二进制 ‘01’ 值，以便实现模块级别串行测试数据路径的故障隔离。

旁路寄存器

当以串行方式将数据移位到寄存器时，跳过某些芯片可能会节省时间。旁路寄存器为单比特寄存器，可置于 TDI 和 TDO 接口之间，这样可以使通过 SRAM 的数据移动的延迟较小。执行 BYPASS 指令时，旁路寄存器会置为低电平 (V_{SS})。

边界扫描寄存器

边界扫描寄存器连接到 SRAM 上的所有输入和双向接口。

当 TAP 控制器处于 Capture-DR 状态时，边界扫描寄存器会加载 RAM 输入和输出环的内容。当控制器转入 Shift-DR 状态后，该寄存器会被置于 TDI 和 TDO 接口之间。EXTEST、SAMPLE/PRELOAD 和 SAMPLE Z 指令用于捕获输入和输出环的内容。

第 19 页上的 [边界扫描顺序](#) 显示了各个位的连接顺序。每个位都与 SRAM 封装上的一个管脚相对应。寄存器的 MSB 被连接到 TDI，LSB 被连接到 TDO。

标识 (ID) 寄存器

当指令寄存器中加载了 IDCODE 指令时，ID 寄存器会在 Capture-DR 状态期间加载供货商特定的 32 位代码。IDCODE 已硬连线到 SRAM 中，当 TAP 控制器处于 Shift-DR 状态时，可以移出它。ID 寄存器具有供应商代码和第 18 页上的 [标识寄存器定义](#) 中所述的其他信息。

TAP 指令集

概况

三位指令寄存器可实现八个不同的指令。第 18 页上的标识代码中列出了所有组合。其中三个指令列为了 **RESERVED**，请勿使用这些指令。本节将详细说明其他五个指令。

当指令寄存器置于 TDI 和 TDO 之间时，这些指令会在 Shift-IR 状态期间加载到 TAP 控制器中。在此状态期间，会通过 TDI 和 TDO 接口将指令写入到指令寄存器内。要在写入指令后立即执行指令，必须使 TAP 控制器转入 Update-IR 状态。

EXTEST

EXTEST 指令用于通过系统输出引脚输出预加载的数据。在 Shift-DR 控制器状态下，该指令还会将用于串行访问的边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。

IDCODE

IDCODE 指令用于将供应商特定的 32 位代码加载到指令寄存器中。它还会将指令寄存器置于 TDI 和 TDO 接口之间，并允许在 TAP 控制器进入 Shift-DR 状态后将 IDCODE 从器件移出。

在上电时，或当 TAP 控制器处于 Test-Logic-Reset 状态时，IDCODE 指令都会被加载到指令寄存器中。

SAMPLE Z

当 TAP 控制器处于 Shift-DR 状态时，SAMPLE Z 指令会将边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 引脚之间。此外，SAMPLE Z 指令还使所有 SRAM 输出进入高阻态。

SAMPLE/PRELOAD

SAMPLE/PRELOAD 是符合 1149.1 标准的强制指令。当 SAMPLE/PRELOAD 指令加载到指令寄存器中并且 TAP 控制器处于 Capture-DR 状态时，边界扫描寄存器中会捕获输入和输出引脚上数据的快照。

TAP 控制器时钟的最高工作频率仅为 20 MHz，而 SRAM 时钟的工作频率要比它高一个数量级。由于在时钟频率方面存在较大差距，因此在 Capture-DR 状态期间，输入或输出可能会出现跃变。TAP 可能在跃变（亚稳态）期间尝试捕获信号。虽然这并不会损坏器件，但无法保证捕获到的值是正确的，并且结果可能无法重复。

为了保证边界扫描寄存器捕获到正确的信号值，SRAM 信号必须在足够长的时间内保持稳定，以达到 TAP 控制器的捕获建立加保持时间（ t_{CS} 和 t_{CH} ）的要求。如果在设计中无法在 SAMPLE/PRELOAD 指令期间停止（或减慢）时钟，则可能无法正确捕获 SRAM 时钟输入。即使存在该问题，但仍可以捕获所有其他信号，只要忽略了边界扫描寄存器中所捕获的 CK 和 CK# 的值即可。

捕获数据后，通过将 TAP 进入 Shift-DR 状态，可以立即移出数据。这会将边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 引脚之间。

在选择另一个边界扫描测试操作之前，PRELOAD 允许在边界扫描寄存器单元的已锁存并行输出处放置一个初始数据样本。

必要时，SAMPLE 和 PRELOAD 阶段的数据移位可以并发执行，即可以在移出所捕获数据的同时，可移入预加载的数据。

BYPASS

当 BYPASS 指令加载到指令寄存器中并且 TAP 处于 Shift-DR 状态时，旁路寄存器会被置于 TDI 和 TDO 球形焊盘之间。BYPASS 指令的优势是当电路板上有多器件连接在一起时，可以缩短边界扫描路径。

EXTEST Output Bus Tri-State

IEEE 标准 1149.1 强制规定，TAP 控制器可以将输出总线置于三态模式。

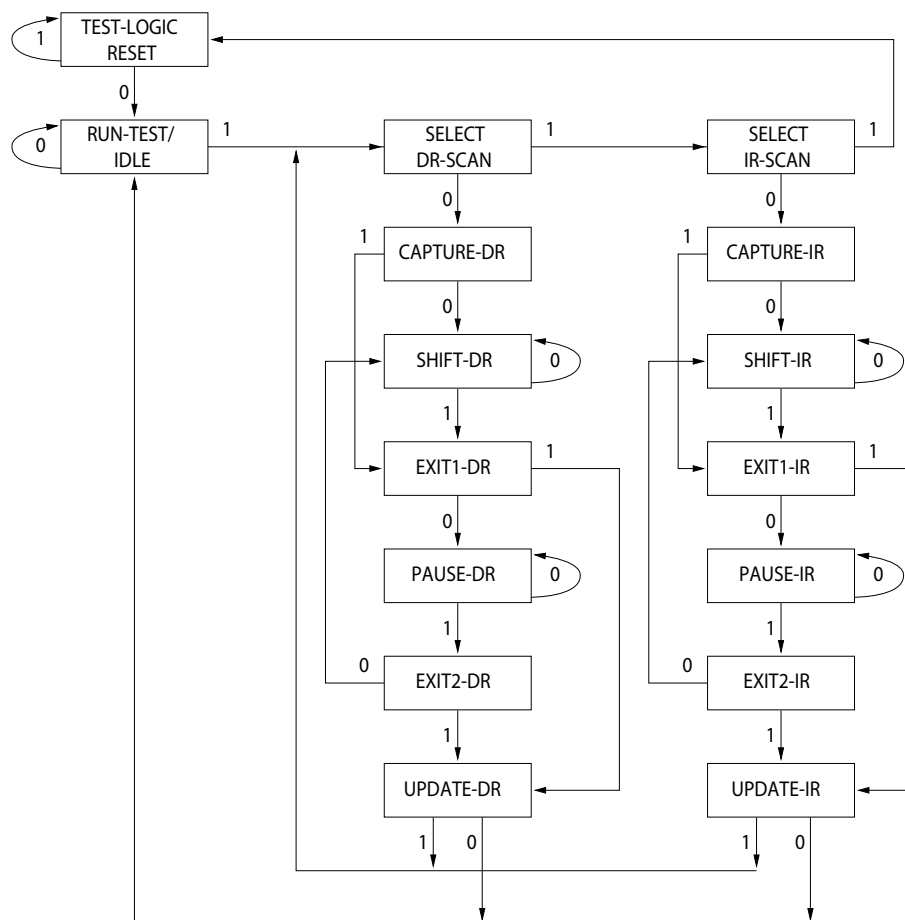
边界扫描寄存器在位 #89 上有一个特殊位（对于 165-FBGA 封装）。当此扫描单元（称为“外测试输出总线三态”）在 TAP 控制器处于 Update-DR 状态期间被锁存到预加载寄存器中时，如果输入 EXTEST 作为当前指令，则该单元会直接控制输出（Q 总线）引脚的状态。在置于高电平时，它将允许输出缓冲区控制输出总线。在置于低电平时，此位会将输出总线置于高阻态。

通过输入 SAMPLE/PRELOAD 或 EXTEST 指令，然后在 Shift-DR 状态期间将所需的位读入到该单元中，即可设置该位。在 Update-DR 期间，被加载到该移位寄存器单元中的值会被锁存到预加载寄存器中。输入 EXTEST 指令后，此位会直接控制输出 Q 总线引脚。请注意，此位会预置为高电平，以便在器件上电时，以及当 TAP 控制器处于 Test-Logic-Reset 状态时，启动输出。

Reserved

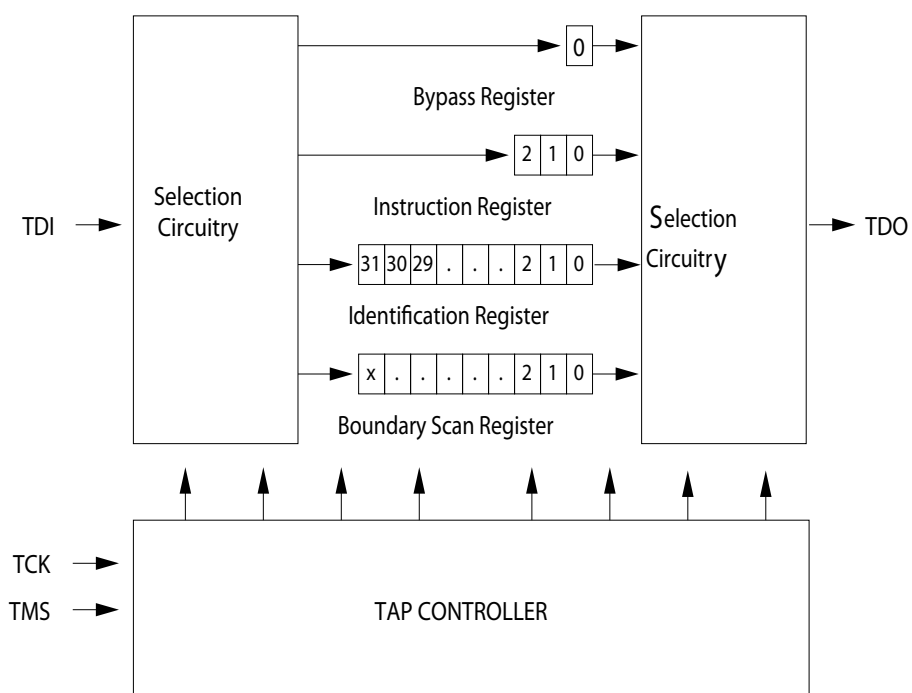
这些指令尚未实现，但可以留作日后使用。请勿使用这些指令。

TAP 控制器状态图



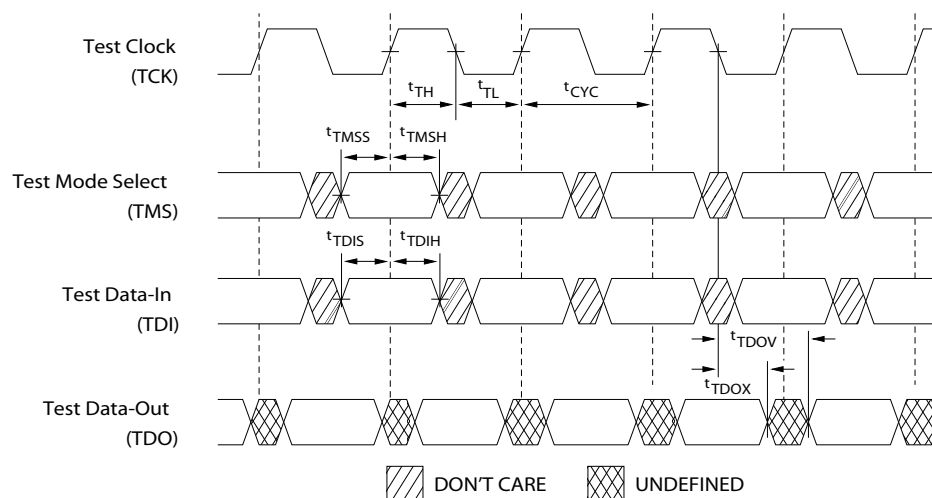
每个状态旁边的‘0’或‘1’代表的是 TCK 上升沿上对应的 TMS 的值。

TAP 控制器框图



TAP 时序

图 3. TAP 时序



TAP 交流开关特性

在工作范围内

参数 ^[8, 9]	说明	最小值	最大值	单位
时钟				
t_{TCYC}	TCK 时钟周期时间	50	—	ns
t_{TF}	TCK 时钟频率	—	20	MHz
t_{TH}	TCK 时钟为高电平的时间	20	—	ns
t_{TL}	TCK 时钟为低电平的时间	20	—	ns
输出时间				
t_{TDOV}	从 TCK 时钟为低电平到 TDO 有效的时间	—	10	ns
t_{TDOX}	从 TCK 时钟为低电平到 TDO 无效的时间	0	—	ns
建立时间				
t_{TMSS}	从 TMS 建立到 TCK 时钟上升沿的时间	5	—	ns
t_{TDIS}	从 TDI 建立到 TCK 时钟上升沿的时间	5	—	ns
t_{CS}	从采样建立到 TCK 上升沿的时间	5	—	ns
保持时间				
t_{TMSH}	TCK 时钟上升沿后的 TMS 保持时间	5	—	ns
t_{TDIH}	时钟上升沿后的 TDI 保持时间	5	—	ns
t_{CH}	时钟上升沿后的捕获保持时间	5	—	ns

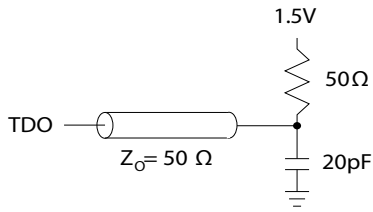
注释:

8. t_{CS} 和 t_{CH} 是指从边界扫描寄存器锁存数据所需要的建立和保持时间。
9. 测试条件是通过使用 TAP 交流测试条件中的负载确定的。 $t_R/t_F = 1$ ns。

3.3 V TAP 交流测试条件

输入脉冲电平 V_{SS} 到 3.3 V
输入上升和下降时间（转换速率） 2 V/ns
输入时序参考电压 1.5 V
输出参考电压 1.5 V
测试负载终端供电电压 1.5 V

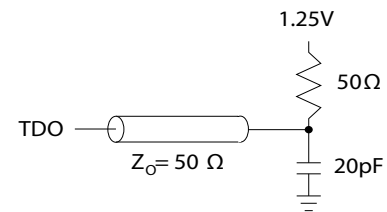
3.3 V TAP 交流输出负载等效



2.5 V TAP 交流测试条件

输入脉冲电平 V_{SS} 到 2.5 V
输入上升和下降时间（转换速率） 2 V/ns
输入时序参考电压 1.25 V
输出参考电压 1.25 V
测试负载终端供电电压 1.25 V

2.5 V TAP 交流输出负载等效



TAP 直流电气特性与工作条件

（除非另有说明，否则其工作条件为：0 °C < T_A < +70 °C； $V_{DD} = 3.3 \text{ V} \pm 0.165 \text{ V}$ ）

参数 ^[10]	说明	测试条件	最小值	最大值	单位
V_{OH1}	输出高电压	$I_{OH} = -4.0 \text{ mA}$, $V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	2.4	—	V
		$I_{OH} = -1.0 \text{ mA}$, $V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	2.0	—	V
V_{OH2}	高电压输出	$I_{OH} = -100 \mu\text{A}$, $V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	2.9	—	V
		$V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	2.1	—	V
V_{OL1}	输出低电压	$I_{OL} = 8.0 \text{ mA}$, $V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	—	0.4	V
		$V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	—	0.4	V
V_{OL2}	低电压输出	$I_{OL} = 100 \mu\text{A}$, $V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	—	0.2	V
		$V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	—	0.2	V
V_{IH}	输入高电压	$V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	2.0	$V_{DD} + 0.3$	V
		$V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	1.7	$V_{DD} + 0.3$	V
V_{IL}	输入低电压	$V_{DDQ} = 3.3 \text{ V}$	-0.3	0.8	V
		$V_{DDQ} = 2.5 \text{ V}$	-0.3	0.7	V
I_X	输入负载电流	$GND \leq V_{IN} \leq V_{DDQ}$	-5	5	μA

注释：

10. 所有电压都参考 V_{SS} （GND）电压。

标识寄存器定义

指令字段	CY7C1380KV33 (512 K × 36)	说明
版本号 (31:29)	000	描述版本编号。
器件深度 (28:24) ^[11]	01011	保留，以供内部使用。
器件宽度 (23:18) 165-FBGA	000000	定义存储器类型和架构。
赛普拉斯公司器件 ID (17:12)	100101	定义器件的宽度和容量。
赛普拉斯 JEDEC ID 代码 (11:1)	00000110100	允许使用 SRAM 供应商的唯一标识。
ID 寄存器存在指示符 (0)	1	表示是否存在 ID 寄存器。

扫描寄存器大小

寄存器名称	位大小 (× 36)
指令	3
旁路	1
ID	32
边界扫描顺序 (165-FBGA 封装)	89

标识代码

指令	代码	说明
EXTEST	000	捕捉 I/O 环内容。将边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。强制所有 SRAM 输出进入高阻态。
IDCODE	001	将供应商 ID 代码加载到 ID 寄存器中，并将该寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。该操作不会影响 SRAM 的工作。
SAMPLE Z	010	捕获 I/O 环内容。将边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。强制所有 SRAM 输出驱动器进入高阻态。
RESERVED	011	请勿使用。此指令留作日后使用。
SAMPLE/PRELOAD	100	捕获 I/O 环内容。将边界扫描寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。该操作不会影响 SRAM 的工作。
RESERVED	101	请勿使用。此指令留作日后使用。
RESERVED	110	请勿使用。此指令留作日后使用。
BYPASS	111	将旁路寄存器置于 TDI 和 TDO 之间。该操作不会影响 SRAM 的工作。

注释：

11. 对于该器件的 2.5 V 和 3.3 V 版本，在寄存器定义中，位 #24 为“1”。

边界扫描顺序

165-BGA [12、13]

位编号	球型焊盘 ID
1	N6
2	N7
3	N10
4	P11
5	P8
6	R8
7	R9
8	P9
9	P10
10	R10
11	R11
12	H11
13	N11
14	M11
15	L11
16	K11
17	J11
18	M10
19	L10
20	K10
21	J10
22	H9
23	H10
24	G11
25	F11
26	E11
27	D11
28	G10
29	F10
30	E10

位编号	球型焊盘 ID
31	D10
32	C11
33	A11
34	B11
35	A10
36	B10
37	A9
38	B9
39	C10
40	A8
41	B8
42	A7
43	B7
44	B6
45	A6
46	B5
47	A5
48	A4
49	B4
50	B3
51	A3
52	A2
53	B2
54	C2
55	B1
56	A1
57	C1
58	D1
59	E1
60	F1

位编号	球型焊盘 ID
61	G1
62	D2
63	E2
64	F2
65	G2
66	H1
67	H3
68	J1
69	K1
70	L1
71	M1
72	J2
73	K2
74	L2
75	M2
76	N1
77	N2
78	P1
79	R1
80	R2
81	P3
82	R3
83	P2
84	R4
85	P4
86	N5
87	P6
88	R6
89	内部

注释:

12. NC (未连接) 的球形焊盘被预设为低电平。
13. 位 # 89 被预设为高电平。

最大额定值

超过最大额定值可能会影响器件的使用寿命。用户指南未经过测试。

存放温度 -65 °C ~ +150 °C

通电时的环境温度 -55 °C ~ +125 °C

V_{DD} 上相对于 GND 的供电电压 -0.3 V ~ +4.6 V

V_{DDQ} 上相对于 GND 的供电电压 -0.3 V ~ + V_{DD}

应用于三态模式下的输出

直流电压 -0.5 V ~ $V_{DDQ} + 0.5$ V

直流输入电压 -0.5 V ~ $V_{DD} + 0.5$ V

输出电流（低电平） 20 mA

静电放电电压

（根据 MIL-STD-883, 方法 3015） > 2001 V

门锁电流 > 200 mA

工作范围

范围	环境温度	V_{DD}	V_{DDQ}
商业级	0 °C ~ +70 °C	3.3 V – 5% / + 10%	2.5 V – 5% ~ V_{DD}
工业级	-40 °C 至 +85 °C		

抗中子软失效

参数	说明	测试条件	典型值	最大值 *	单位
LSBU (无 ECC 的器件)	逻辑单比特 错误	25 °C	197	216	FIT/ Mb
LMBU	逻辑多比特 错误	25 °C	0	0.01	FIT/ Mb
SEL	单粒子门锁	85 °C	0	0.1	FIT/ Dev

* 测试期间未出现 LMBU 或 SEL 事件; 该列为统计得出的 χ^2 , 按 95% 置信区间计算。如需详细信息, 请参考应用笔记 AN 54908 “加速抗中子 SER 测试和陆生故障率的计算”。

电气特性

在工作范围内

参数 [14、15]	说明	测试条件	最小值	最大值	单位
V_{DD}	电源电压		3.135	3.6	V
V_{DDQ}	I/O 供电电压	3.3 V I/O	3.135	V_{DD}	V
		2.5 V I/O	2.375	2.625	V
V_{OH}	输出高电压	I/O 电压 = 3.3 V, $I_{OH} = -4.0$ mA	2.4	–	V
		I/O 电压 = 2.5 V, $I_{OH} = -1.0$ mA	2.0	–	V
V_{OL}	输出低电压	I/O 电压 = 3.3 V, $I_{OL} = 8.0$ mA	–	0.4	V
		2.5 V I/O, $I_{OL} = 1.0$ mA	–	0.4	V
V_{IH}	输入高电压 [14]	I/O 电压为 3.3 V	2.0	$V_{DD} + 0.3$ V	V
		2.5 V I/O	1.7	$V_{DD} + 0.3$ V	V
V_{IL}	输入低电压 [14]	I/O 电压为 3.3 V	-0.3	0.8	V
		2.5 V I/O	-0.3	0.7	V
I_X	输入漏电流 (ZZ 和 MODE 除外)	$GND \leq V_I \leq V_{DDQ}$	-5	5	mA
	MODE 的输入电流	输入 = V_{SS}	-30	–	mA
		输入 = V_{DD}	–	5	mA
	ZZ 的输入电流	输入 = V_{SS}	-5	–	mA
		输入 = V_{DD}	–	30	mA
I_{OZ}	输出漏电流	$GND \leq V_I \leq V_{DDQ}$, 输出被禁用	-5	5	mA

注释:

14. 过冲: $V_{IH(AC)} < V_{DD} + 1.5$ V (脉冲宽度小于 $t_{CYO}/2$), 下冲: $V_{IL(AC)} > -2$ V (脉冲宽度小于 $t_{CYO}/2$)。

15. $T_{Power-up}$: 假设在至少 200 ms 内从 0 V 的电压线性上升至 $V_{DD(min)}$ 。在此期间, $V_{IH} < V_{DD}$ 和 $V_{DDQ} \leq V_{DD}$ 。

电气特性 (续)

在工作范围内

参数 ^[14、15]	说明	测试条件			最小值	最大值	单位
I _{DD}	V _{DD} 的工作电流	V _{DD} = 最大值, I _{OUT} = 0 mA, f = f _{MAX} = 1/t _{CYC}	4 ns 周期, 250 MHz	× 18	—	180	mA
				× 36	—	200	
			5 ns 周期, 200 MHz	× 18	—	158	
				× 36	—	178	
			6 ns 周期, 167 MHz	× 18	—	143	
				× 36	—	163	
I _{SB1}	自动 CE 断电电流 — TTL 输入	最大 V _{DD} , 取消选择器件, V _{IN} ≥ V _{IH} 或 V _{IN} ≤ V _{IL} , f = f _{MAX} = 1/t _{CYC}	4 ns 周期, 250 MHz	× 18	—	75	mA
				× 36	—	80	
			5 ns 周期, 200 MHz	× 18	—	75	
				× 36	—	80	
			6 ns 周期, 167 MHz	× 18	—	75	
				× 36	—	80	
I _{SB2}	自动 CE 断电电流 — CMOS 输入	最大 V _{DD} , 取消选择器件, V _{IN} ≤ 0.3 V 或 V _{IN} ≥ V _{DDQ} - 0.3 V, f = 0	所有速度范围	× 18	—	65	mA
				× 36	—	70	
I _{SB3}	自动 CE 断电电流 — CMOS 输入	最大 V _{DD} , 取消选择器件, V _{IN} ≤ 0.3 V 或 V _{IN} ≥ V _{DDQ} - 0.3 V, f = f _{MAX} = 1/t _{CYC}	4 ns 周期, 250 MHz	× 18	—	75	mA
				× 36	—	80	
			5 ns 周期, 200 MHz	× 18	—	75	
				× 36	—	80	
			6 ns 周期, 167 MHz	× 18	—	75	
				× 36	—	80	
I _{SB4}	自动 CE 断电电流 — TTL 输入	最大 V _{DD} , 取消选择器件, V _{IN} ≥ V _{IH} 或 V _{IN} ≤ V _{IL} , f = 0	所有速度范围	× 18	—	65	mA
				× 36	—	70	

电容

参数	说明	测试条件	100-TQFP 封装	165-FBGA 封装	单位
C_{IN}	输入电容	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{DD} = 3.3\text{ V}$, $V_{DDQ} = 2.5\text{ V}$	5	5	pF
C_{CLK}	时钟输入电容		5	5	pF
C_{IO}	输入 / 输出电容		5	5	pF

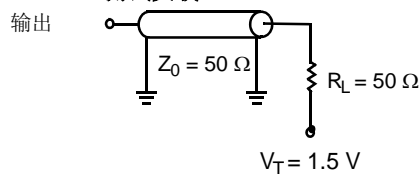
热阻

参数	说明	测试条件		100-TQFP 封装	165-FBGA 封装	单位
Θ_{JA}	热阻（结至环境）	根据 EIA/JESD51 的要求， 测试条件遵循测试热阻的 标准测试方法和流程。	静气（0 m/s）	37.95	17.34	°C/W
			气流（1 m/s）	33.19	14.33	°C/W
			气流（3 m/s）	30.44	12.63	°C/W
Θ_{JB}	热阻（结至板上）		--	24.07	8.95	°C/W
Θ_{JC}	热阻（结至外壳）	8.36		3.50	°C/W	

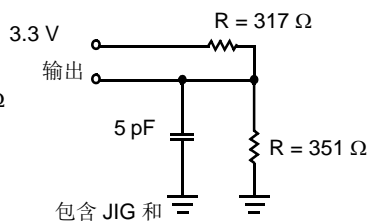
交流测试负载和波形

图 4. 交流测试负载和波形

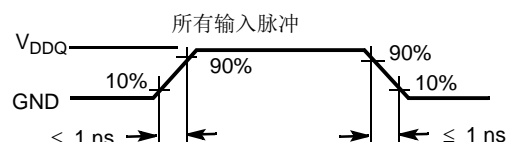
3.3 V I/O 测试负载



(a)

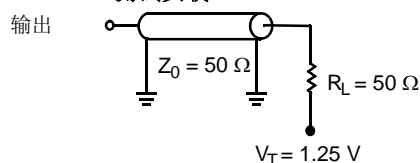


(b)

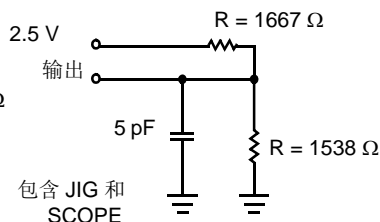


(c)

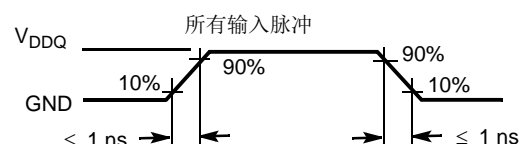
2.5 V I/O 测试负载



(a)



(b)



(c)

切换特性

在工作范围内

参数 ^[16、17]	说明	250 MHz		200 MHz		167 MHz		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{POWER}	从 V_{DD} （典型值）到第一次访问的时间 ^[18]	1	—	1	—	1	—	ms
时钟								
t_{CYC}	时钟周期时间	4.0	—	5	—	6	—	ns
t_{CH}	时钟为高电平的时间	1.5	—	2.0	—	2.2	—	ns
t_{CL}	时钟为低电平的时间	1.5	—	2.0	—	2.2	—	ns
输出时间								
t_{CO}	CLK 上升沿后数据输出有效的时间	—	2.5	—	3.2	—	3.4	ns
t_{DOH}	CLK 上升沿后数据输出的保持时间	1.0	—	1.5	—	1.5	—	ns
t_{CLZ}	从时钟到数据为低阻态的时间 ^[19、20、21]	1.0	—	1.3	—	1.5	—	ns
t_{CHZ}	从时钟到数据为高阻态的时间 ^[19、20、21]	—	2.6	—	3.0	—	3.4	ns
$t_{OE\bar{V}}$	从 \bar{OE} 为低电平到输出有效的时间	—	2.6	—	3.0	—	3.4	ns
$t_{OE\bar{LZ}}$	\bar{OE} 为低电平到输出为低阻态的时间 ^[19、20、21]	0	—	0	—	0	—	ns
$t_{OE\bar{HZ}}$	\bar{OE} 为高电平到输出为高阻态的时间 ^[19、20、21]	—	2.6	—	3.0	—	3.4	ns
建立时间								
t_{AS}	CLK 上升沿前的地址建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
t_{ADS}	CLK 上升沿前的 \bar{ADSC} 、 \bar{ADSP} 建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
t_{ADVS}	CLK 上升沿前的 \bar{ADV} 建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
t_{WES}	CLK 上升沿前的 \bar{GW} 、 \bar{BWE} 、 \bar{BW}_X 建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
t_{DS}	CLK 上升沿前的数据输入建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
t_{CES}	CLK 上升沿前的芯片使能建立时间	1.2	—	1.4	—	1.5	—	ns
保持时间								
t_{AH}	CLK 上升沿后的地址保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns
t_{ADH}	CLK 上升沿后的 \bar{ADSP} 、 \bar{ADSC} 保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns
t_{ADVH}	CLK 上升沿后的 \bar{ADV} 保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns
t_{WEH}	CLK 上升沿后的 \bar{GW} 、 \bar{BWE} 、 \bar{BW}_X 保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns
t_{DH}	CLK 上升沿后数据输入的保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns
t_{CEH}	CLK 上升沿后芯片使能的保持时间	0.3	—	0.4	—	0.5	—	ns

注释:

16. $V_{DDQ} = 3.3\text{ V}$ 时, 时序参考电压为 1.5 V; $V_{DDQ} = 2.5\text{ V}$ 时, 时序参考电压为 1.25 V。

17. 除非另有说明, 否则测试条件都如第 22 页上的图 4 的 (a) 情况显示。

18. 该器件内部使用了一个电压调节器; t_{POWER} 是指启动读 / 写操作前供电电压超过 $V_{DD(\text{minimum})}$ 所需的时间。

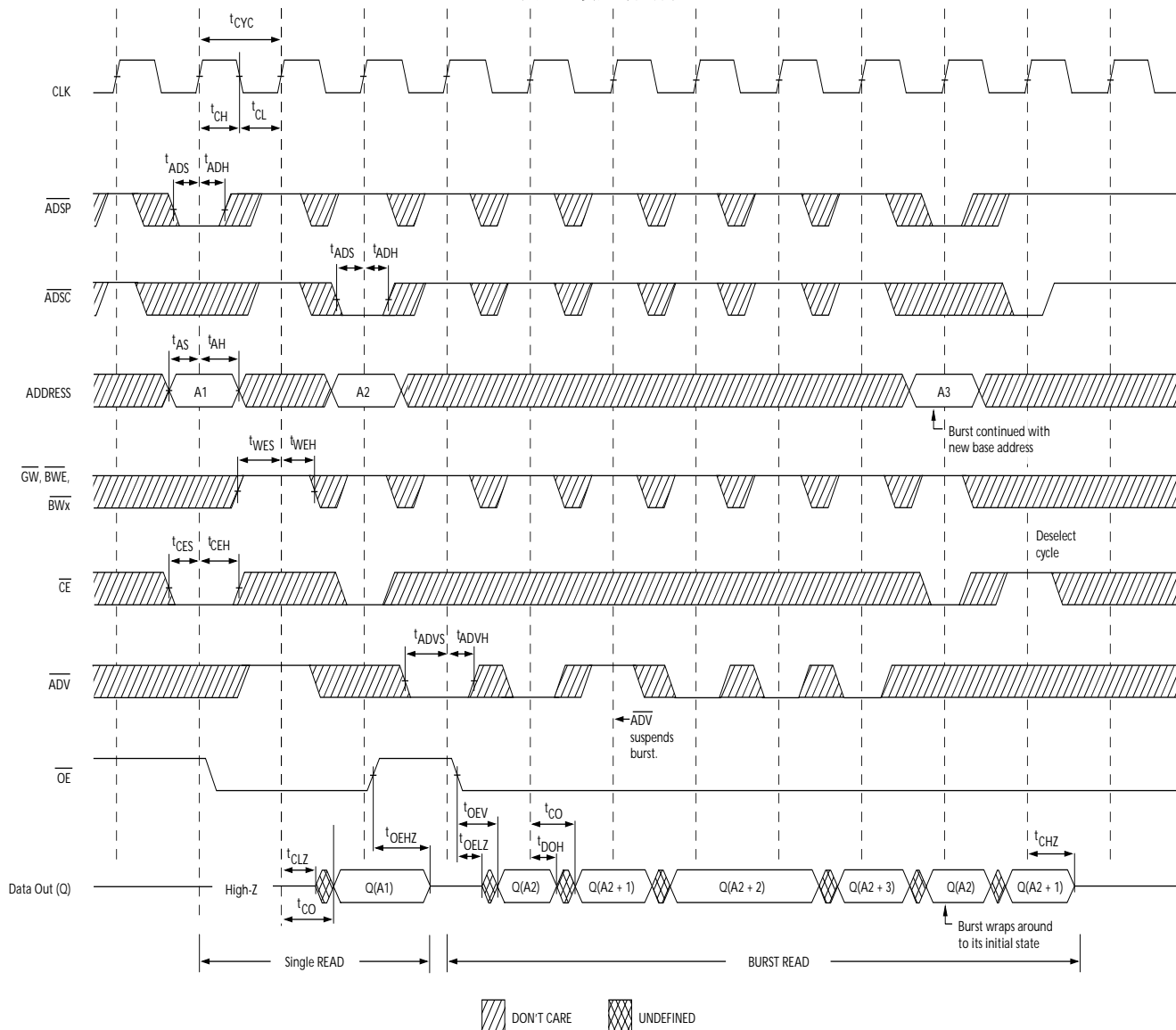
19. t_{CHZ} 、 t_{CLZ} 、 $t_{OE\bar{LZ}}$ 和 $t_{OE\bar{HZ}}$ 都在第 22 页上的图 4 的 (b) 部分所示的交流电测试条件下指定的。跃变在稳定状态电压 $\pm 200\text{ mV}$ 的条件下测量。

20. 在任何给定的电压和温度情况下, $t_{OE\bar{HZ}}$ 小于 $t_{OE\bar{LZ}}$, t_{CHZ} 小于 t_{CLZ} , 这样在共享同一个数据总线时能够排除总线冲突。这些规范并不表示一个总线冲突条件, 但反映了在最坏的情况下得到保证的参数。设计器件是为了在同一个系统条件下进入低阻状态前处于高阻状态。

21. 该参数定期采样, 并非 100% 经过了测试。

切换波形

图 5. 读周期时序 [22]

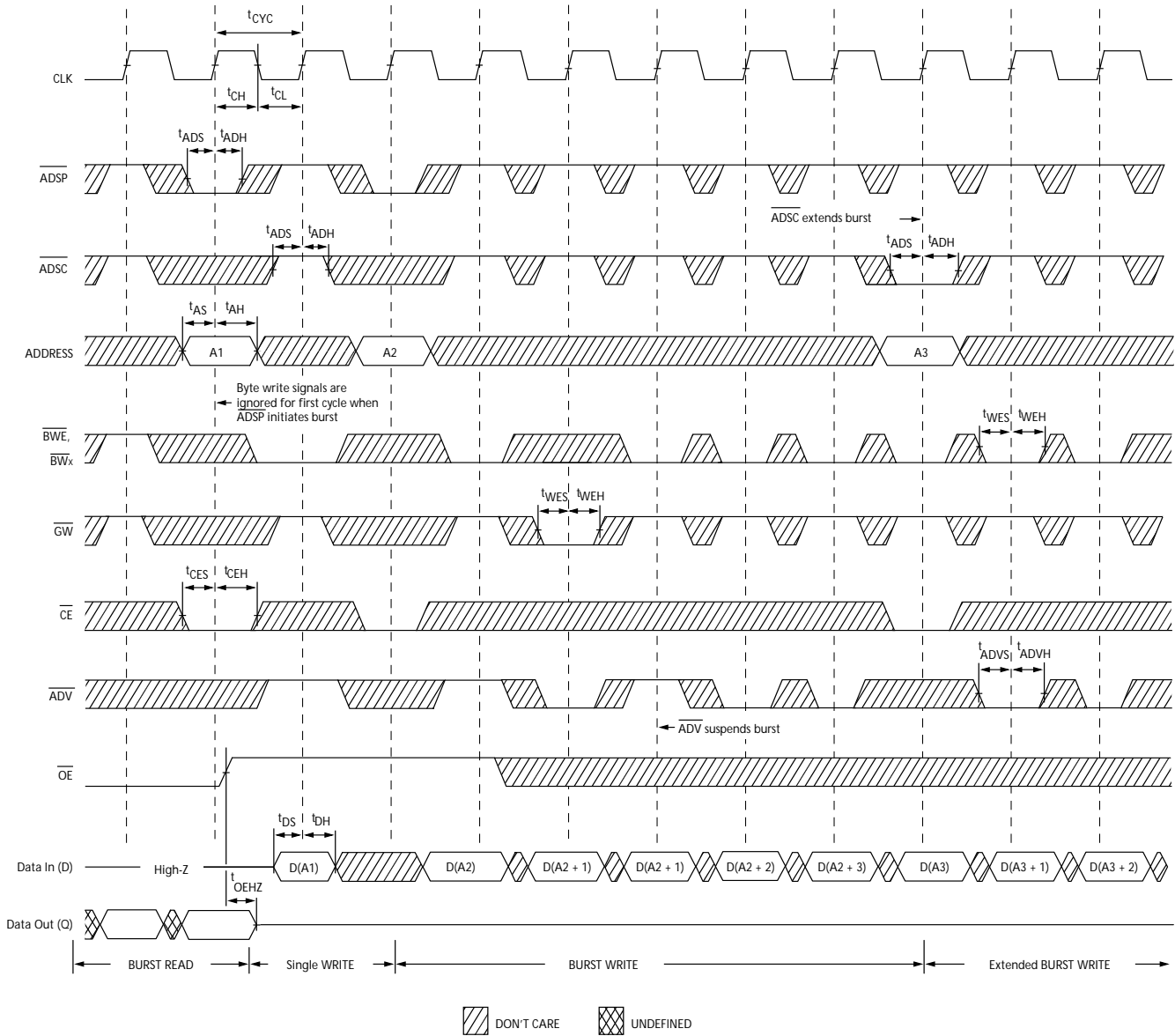


注释:

22. 在该框图中, 当 \overline{CE} 为低电平时: \overline{CE}_1 和 \overline{CE}_3 均为低电平, 而 CE_2 为高电平。当 \overline{CE} 为高电平时: \overline{CE}_1 为高电平, 或 \overline{CE}_3 为高电平, CE_2 为低电平。

切换波形 (续)

图 6. 写周期时序 [23、24]



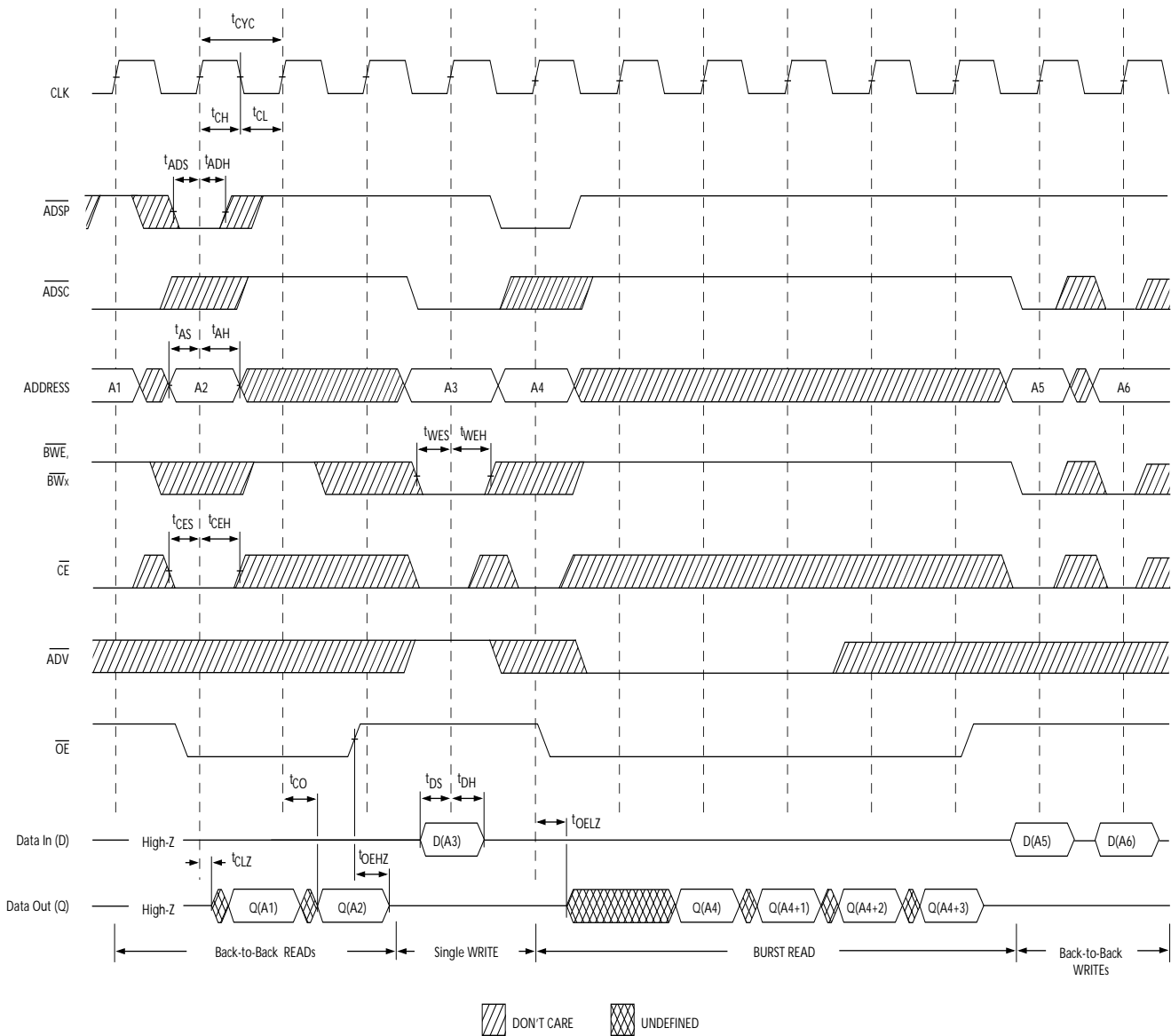
注释:

23. 在该框图中, 当 \overline{CE} 为低电平时: \overline{CE}_1 和 \overline{CE}_3 为低电平, CE_2 为高电平。当 \overline{CE} 为高电平时: \overline{CE}_1 或 \overline{CE}_3 为高电平, 或 CE_2 为低电平。

24. 通过将 \overline{GW} 设为低电平, 或将 \overline{GW} 设为高电平、将 \overline{BWE} 以及 \overline{BW}_x 设为低电平, 可以启动全宽写周期。

切换波形 (续)

图 7. 读 / 写周期时序 [25、26、27]



注释:

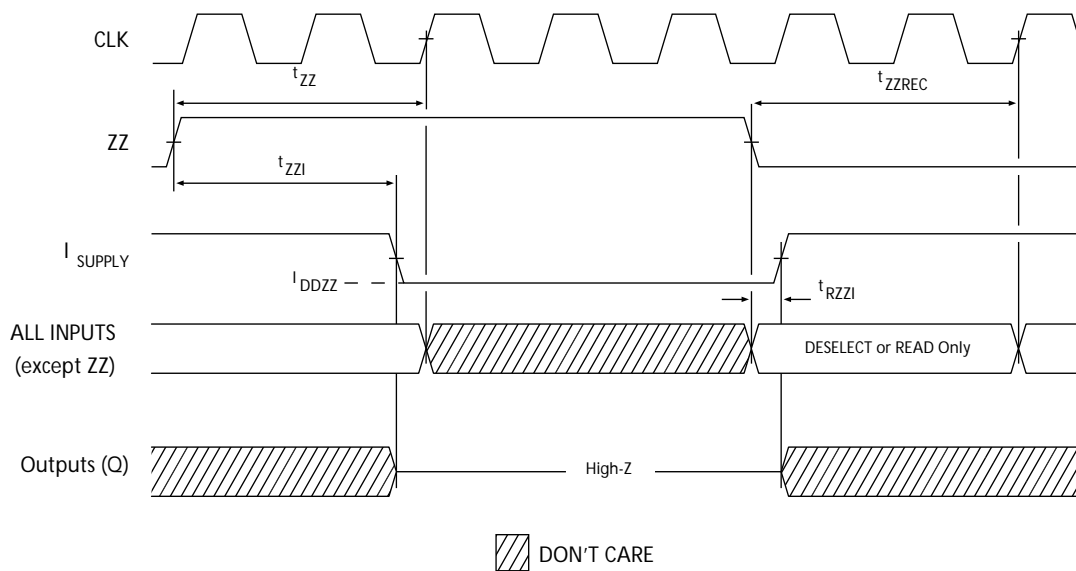
25. 在该框图中, 当 \overline{CE} 为低电平时: \overline{CE}_1 为低电平, CE_2 为高电平以及 \overline{CE}_3 为低电平。当 \overline{CE} 为高电平时: \overline{CE}_1 或 \overline{CE}_3 为高电平, 或 CE_2 为低电平。

26. 如果一个新读取访问不是由 ADSP 或 ADSC 启动的, 则发生写周期后, 数据总线 (Q) 一直处于高阻态。

27. GW 为高电平。

切换波形 (续)

图 8. ZZ 模式时序 [28、29]



注释:

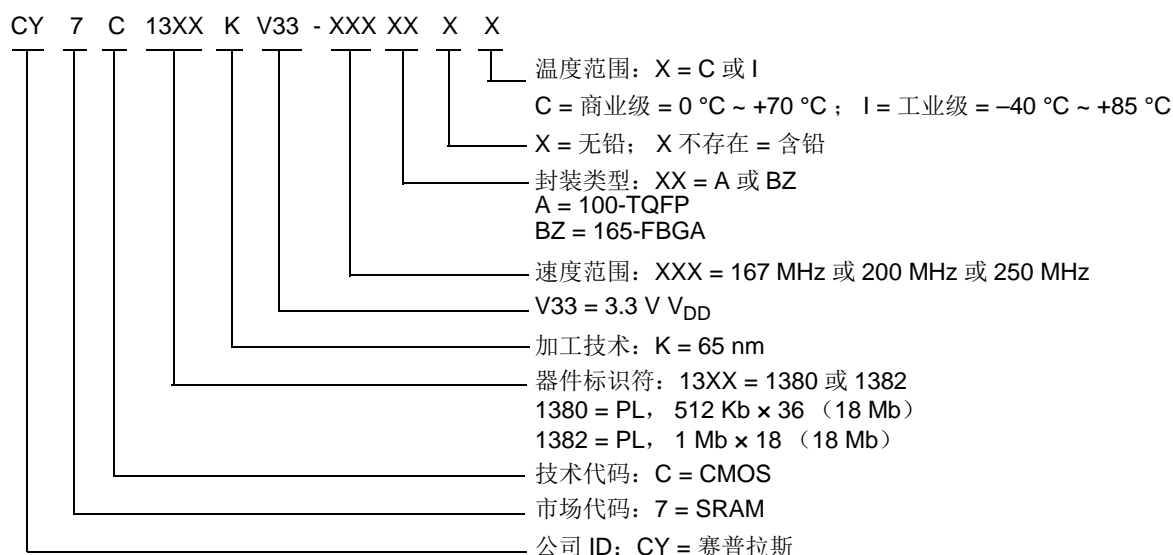
28. 进入 ZZ 模式时, 必须取消选择该器件。有关取消选择器件的所有可能信号条件, 请参考周期说明表。
29. 退出 ZZ 睡眠模式时, DQ 处于高阻态。

订购信息

下表列出了器件的关键封装特性和订购代码。该表仅包含了当前可用的器件。如果您未找到所需的部件，请与当地销售代表联系。欲了解更多信息，请访问赛普拉斯公司网站 www.cypress.com，并参考 <http://www.cypress.com/products> 上的产品汇总页。

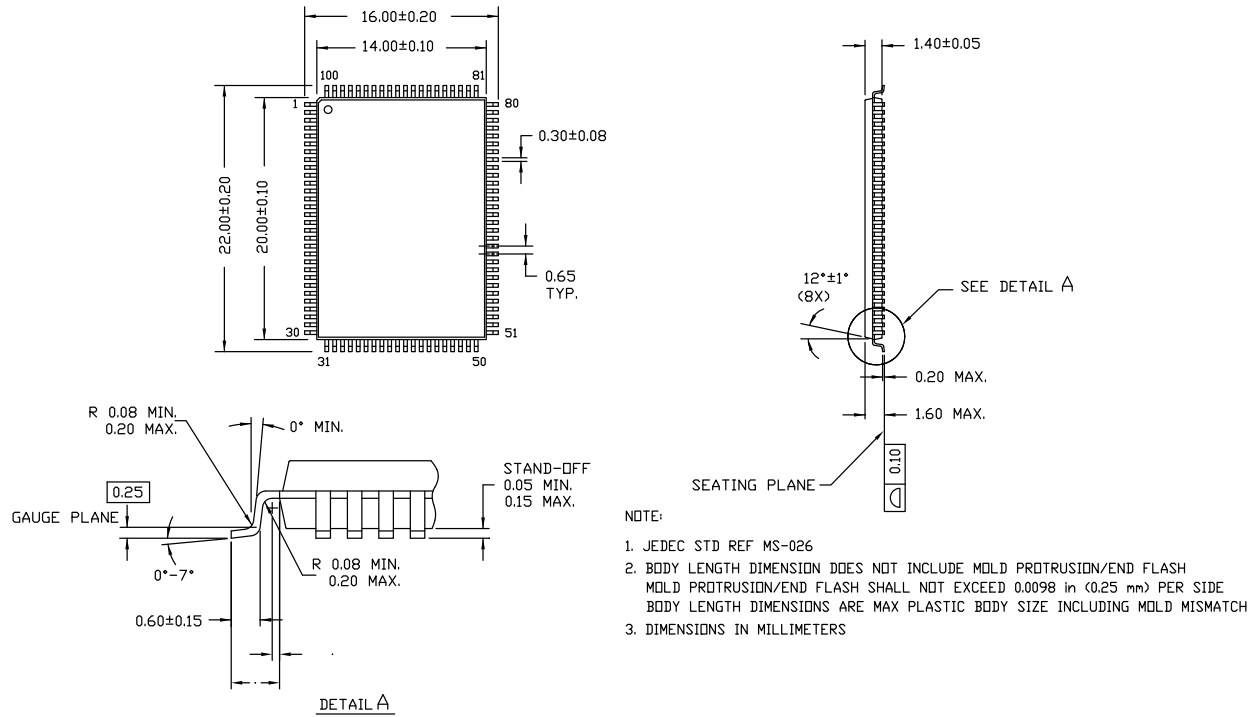
速度 (MHz)	订购代码	封装图	器件和封装类型	工作范围
250	CY7C1380KV33-250AXC	51-85050	100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) 无铅	商业级
200	CY7C1380KV33-200AXC	51-85050	100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) 无铅	商业级
	CY7C1382KV33-200AXC			
167	CY7C1380KV33-167AXC	51-85050	100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) 无铅	商业级
	CY7C1382KV33-167AXC	51-85050	100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) 无铅	工业级
	CY7C1380KV33-167AXI			
	CY7C1380KV33-167BZI	51-85180	165-FBGA (13 × 15 × 1.4 mm)	

订购代码定义



封装图

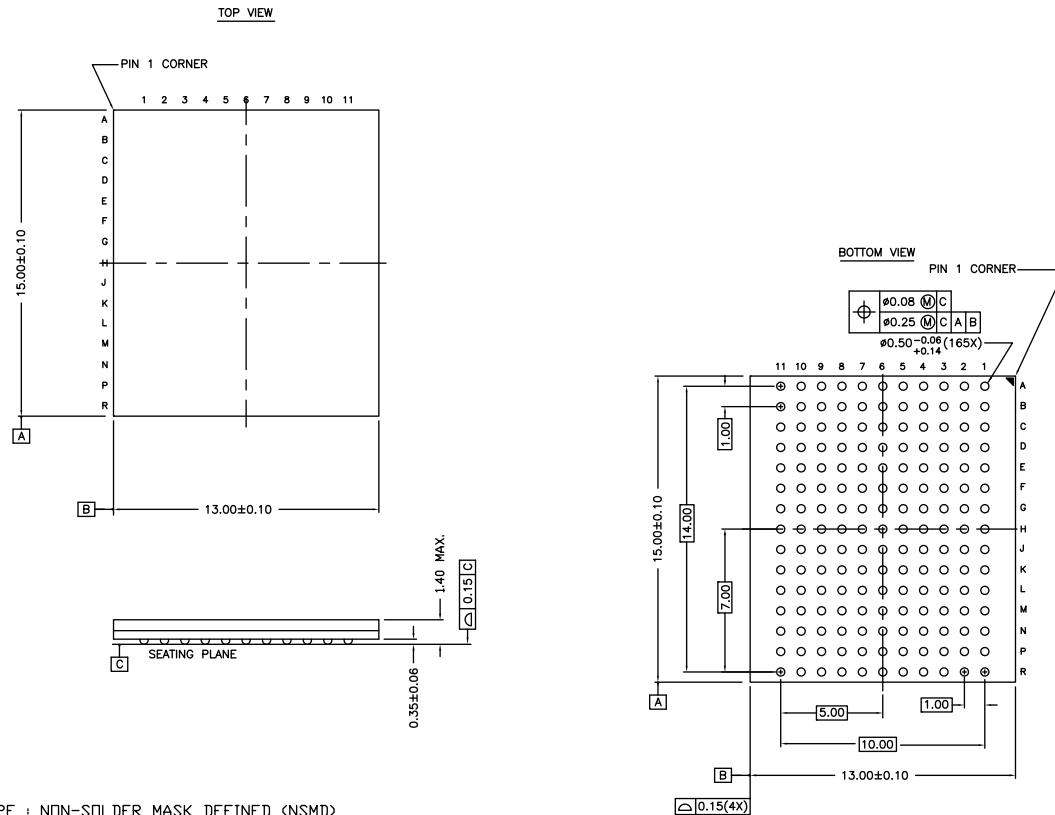
图 9. 100-TQFP (14 × 20 × 1.4 mm) A100RA 封装外形, 51-85050



51-85050 *E

封装图 (续)

图 10. 165-FBGA (13 × 15 × 1.4 mm) BB165D/BW165D (0.5 球形焊盘直径) 封装外形, 51-85180



NOTES :

SOLDER PAD TYPE : NON-SOLDER MASK DEFINED (NSMD)

JEDEC REFERENCE : MO-216 / ISSUE E

PACKAGE CODE : BB0AC/BW0AC

PACKAGE WEIGHT : SEE CYPRESS PACKAGE MATERIAL DECLARATION DATASHEET (PMDD) POSTED ON THE CYPRESS WEB.

51-85180 *G

缩略语

缩略语	说明
CMOS	互补金属氧化物半导体
FBGA	小间距球栅阵列
I/O	输入 / 输出
JTAG	联合测试行动小组
LSB	最低有效位
MSB	最高有效位
OE	输出使能
SRAM	静态随机存取存储器
TCK	测试时钟
TMS	测试模式选择
TDI	测试数据输入
TDO	测试数据输出
TQFP	薄型四方扁平封装
TTL	晶体管 - 晶体管逻辑

文档规范

测量单位

符号	测量单位
°C	摄氏度
MHz	兆赫兹
μA	微安
mA	毫安
mm	毫米
ms	毫秒
ns	纳秒
Ω	欧姆
%	百分比
pF	皮法
V	伏特
W	瓦特

文档修订记录

文档标题: CY7C1380KV33/CY7C1382KV33, 18 Mbit (512 K × 36/1 M × 18) 流水线 SRAM 文档编号: 001-98223				
版本	ECN 编号	变更者	提交日期	变更说明
**	4854101	LISZ	07/27/2015	本文档版本号为 Rev**, 译自英文版 001-97878 Rev**。
*A	5013018	LISZ	11/16/2015	本文档版本号为 Rev*A, 译自英文版 001-97878 Rev*B。

销售、解决方案和法律信息

全球销售和设计支持

赛普拉斯公司拥有一个由办事处、解决方案中心、厂商代表和经销商组成的全球性网络。要找到离您最近的办事处，请访问[赛普拉斯所在地](#)。

产品

汽车级产品

cypress.com/go/automotive

时钟与缓冲器

cypress.com/go/clocks

接口

cypress.com/go/interface

照明与电源控制

cypress.com/go/powerpsoc

存储器

cypress.com/go/memory

PSoC

cypress.com/go/psoc

触摸感应产品

cypress.com/go/touch

USB 控制器

cypress.com/go/USB

无线 / 射频

cypress.com/go/wireless

PSoC® 解决方案

psoc.cypress.com/solutions

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP

赛普拉斯开发者社区

[社区](#) | [论坛](#) | [博客](#) | [视频](#) | [培训](#)

技术支持

cypress.com/go/support

© 赛普拉斯半导体公司，2015。此处所包含的信息可能会随时更改，恕不另行通知。除赛普拉斯产品内嵌的电路外，赛普拉斯半导体公司不对任何其他电路的使用承担任何责任。也不根据专利或其他权利以明示或暗示的方式授予任何许可。除非与赛普拉斯签订明确的书面协议，否则赛普拉斯不保证产品能够用于或适用于医疗、生命支持、救生、关键控制或安全应用领域。此外，对于可能发生运转异常和故障并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统，则表示制造商将承担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。

所有源代码（软件和/或固件）均归赛普拉斯半导体公司（赛普拉斯）所有，并受全球专利法规（美国和美国以外的专利法规）、美国版权法以及国际条约规定的保护和约束。赛普拉斯据此向获许可者授予适用于个人的、非独占性、不可转让的许可，用以复制、使用、修改、创建赛普拉斯源代码的派生作品、编译赛普拉斯源代码和派生作品，并且其目的只能是创建自定义软件和/或固件，以支持获许可者仅将其获得的产品依照适用协议规定的方式与赛普拉斯集成电路配合使用。除上述指定的用途外，未经赛普拉斯明确的书面许可，不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、编译或演示。

免责声明：赛普拉斯不针对此材料提供任何类型的明示或暗示保证，包括（但不限于）针对特定用途的适销性和适用性的暗示保证。赛普拉斯保留在不做出通知的情况下对此处所述材料进行更改的权利。赛普拉斯不对此处所述之任何产品或电路的应用或使用承担任何责任。对于可能发生运转异常和故障，并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统，则表示制造商将承担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。

产品使用可能受适用于赛普拉斯软件许可协议的限制。